



## Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22966XF

Issue Date: 04 Jan 2021

<b>Title of Change:</b>	Wafer Fab Capacity Expansion for Trench 6 MOSFET Technology at Global Foundries in New York, US.	
<b>Proposed First Ship date:</b>	04 Apr 2021 or earlier if approved by customer	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com">MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com</a>	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Additional Reliability Data:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Robert.Baran@onsemi.com">Robert.Baran@onsemi.com</a>	
<b>Type of Notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>	
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Material will be traceable with ONs lot trace code & tracking	
<b>Change Category:</b>	Wafer Fab Change	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Manufacturing Site Addition	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>ON Semiconductor Sites</b>	<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
None	Global Foundries East Fishkill, New York, United States	
<b>Description and Purpose:</b>		
<p>This Product Change Notification, which is intended to add capacity for ON's 60V Trench 6 MOSFET technology products, is announcing the addition of the Global Foundries Fab located in New York, US, for the manufacturing of these products.</p> <p>The changes include Global Foundries as an additional site for wafer fabrication, back grind and back metal, utilizing 300mm diameter wafers, as compared to our existing sites using 200mm wafers.</p> <p>There is no change to the orderable part number.</p> <p>There is no product marking change as a result of this change.</p>		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Wafer Fabrication Site	ON Aizu, Japan ON Gresham, US	ON Aizu, Japan ON Gresham, US <b>Global Foundries, US</b>
Wafer Diameter	200mm (existing sites)	300mm (Global Foundries)
Wafer Probe Site	ON Seremban, Malaysia ON Bucheon, Korea	ON Seremban, Malaysia ON Bucheon, Korea <b>Global Foundries, US</b>
Back Grind, Back Metal Site	ON ISMF, Malaysia ON Bucheon, Korea	ON ISMF, Malaysia ON Bucheon, Korea <b>Global Foundries, US</b>

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME: NVMF55C604NLT1G

RMS: 66102, 67568, 74121

PACKAGE: SO8FL-HE

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vds	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off =2 min	15000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1 @ 260°C		

QV DEVICE NAME: NTMF55C628NLT1G

RMS: 72954

PACKAGE: SO8FL

Test	Specification	Condition	Interval	Result
HTRB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vds	168 hrs	0/231

QV DEVICE NAME: NVTF55C680NLTAG

RMS: 66103, 67569

PACKAGE: u8FL

Test	Specification	Condition	Interval	Result
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off =2 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1 @ 260°C		

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NTTFS5CS73NLTAG	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G, NVTFS5C680NLTAG
NTMFS5C604NLT1G	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTMFS5C612NLT1G	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTMFS5C628NLT1G	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTMFS5C670NLT1G	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTTFS5C658NLTAG	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G, NVTFS5C680NLTAG
NTMFS5C604NLT1G-UIL3	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTMFS5C612NLT1G-UIL5	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G
NTMFS5C628NLT3G	NVMFS5C604NLT1G, NTMFS5C628NLT3G

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22966XF

発行日: 04 Jan 2021

変更件名:	グローバルファンドリー (ニューヨーク、米国)にて Trench 6 MOSFET テクノロジー製品のウェハー工場生産能力拡大	
初回出荷予定日:	04 Apr 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所ま <a href="mailto:MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com">MohdHezri.AbuBakar@onsemi.com</a> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所また <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所ま <a href="mailto:Robert.Baran@onsemi.com">Robert.Baran@onsemi.com</a> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	材料はオンのトレースコードとトラッキングにてトレースできます。	
変更カテゴリ: ウェハーフアブの変更		
変更サブカテゴリ: 製造拠点の追加		
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
無し	Global Foundries East Fishkill, New York, United States	
説明および目的:		
<p>本製品変更通知は、オンの 60V Trench 6 MOSFET テクノロジー製品の生産能力拡大とニューヨーク (米国) にあるグローバルファンドリーを対象製品の製造拠点として追加することをお知らせするものです。</p> <p>変更はグローバルファンドリーを、200mm 径ウェハーを使用する既存の拠点に比べて、300mm 径ウェハーを使用してウェハー製造、バックグラインド、そしてバックメタルの工程の追加拠点として認定することを含みます。</p> <p>オーダー可能な製品番号に変更はありません。</p> <p>本変更の結果として製品マーキングに変更はありません。</p>		
	変更前の表記	変更後の表記
ウェハー製造拠点	ON Aizu, Japan ON Gresham, US	ON Aizu, Japan ON Gresham, US <u>Global Foundries, US</u>
ウェハー径	200mm (existing sites)	300mm (Global Foundries)
ウェハープローブ拠点	ON Seremban, Malaysia ON Bucheon, Korea	ON Seremban, Malaysia ON Bucheon, Korea <u>Global Foundries, US</u>
バックグラインド、バックメタル拠点	ON ISMF, Malaysia ON Bucheon, Korea	ON ISMF, Malaysia ON Bucheon, Korea <u>Global Foundries, US</u>



## 信頼性データの要約:

デバイス名: NVMF55C604NLT1G

RMS : 66102, 67568, 74121

パッケージ: SO8FL-HE

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vds	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off =2 min	15000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1 @ 260°C		

デバイス名: NTMF55C628NLT1G

RMS : 72954

パッケージ: SO8FL

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=175°C, 100% max rated Vds	168 hrs	0/231

デバイス名: NVTF55C680NLTAG

RMS : 66103, 67569

パッケージ: u8FL

テスト	仕様	条件	間隔	結果
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off =2 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1 @ 260°C		

## 電気的特性の要約:

電気的特性に影響はありません。



## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NTTF55CS73NLTAG	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G, NVTF55C680NLTAG
NTMF55C604NLT1G	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTMF55C612NLT1G	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTMF55C628NLT1G	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTMF55C670NLT1G	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTTF55C658NLTAG	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G, NVTF55C680NLTAG
NTMF55C604NLT1G-UIL3	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTMF55C612NLT1G-UIL5	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G
NTMF55C628NLT3G	NVMF55C604NLT1G, NTMF55C628NLT3G